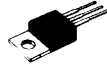


2SB1273



2010A

PNPエビタキシャルプレーナ形
シリコントランジスタ

低周波電力増幅用

Ⓔ2332

用途 ・電力増幅一般用。

- 特長 ・ASOが広い(MBITプロセス採用)。
 ・飽和電圧が低い。
 ・高信頼性である。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/Ta=25°C		unit	
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	-60	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6	V
コレクタ電流	I _C	-3	A
ピークコレクタ電流	i _{cp}	-8	A
コレクタ損失	P _C	1.75	W
	T _c =25°C	30	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

電気的特性 Electrical Characteristics/Ta=25°C			min	typ	max	unit
コレクタしや断電流	I _{CB0}	V _{CB} =-40V, I _E =0			-100	μA
エミッタしや断電流	I _{EB0}	V _{EB} =-4V, I _C =0			-100	μA
直流電流増幅率	h _{FE} (1)	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A	70*		280*	
	h _{FE} (2)	V _{CE} =-5V, I _C =-3A	20			
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A		100		MHz
出力容量	c _{ob}	V _{CB} =-10V, f=1MHz		60		pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =-2A, I _B =-0.2A		-0.4	-1	V
ベース・エミッタ電圧	V _{BE}	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A		-0.8	-1	V
コレクタ・ベース降伏電圧	V(BR) _{CB0}	I _C =-1mA, I _E =0	-60			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V(BR) _{CE0}	I _C =-5mA, R _{BE} =∞	-60			V
エミッタ・ベース降伏電圧	V(BR) _{EB0}	I _E =-1mA, I _C =0	-6			V

※2SB1273は 0.5A h_{FE}により次のように分類している。

70	q	140	100	R	200	140	S	280
----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2010A
(unit: mm)

